

## 記者発表

件名	室温で世界最高の磁気抵抗比 287%をもつ TMR 素子の開発に成功 高集積・高速・低消費電力の MRAM 実現に道を開く
概要	<p>文部科学省の研究開発委託事業「ITプログラム」の課題の一つである「高機能・超低消費電力メモリの開発」プロジェクト（プロジェクトリーダー：大野英男、東北大学電気通信研究所附属ナノ・スピン実験施設教授）は、東北大学電気通信研究所大野英男教授と日立製作所基礎研究所の共同で世界最高出力（磁気抵抗比 287%）をもつ金属系トンネル磁気抵抗（TMR）素子の開発に成功しました。</p> <p>本研究成果は、高集積・高速・低消費電力の新たな超ギガビット級磁気メモリ開発に道を開くものです。さらに、HDD用ヘッドや高感度磁界センサーなどの磁気抵抗素子を応用した磁気デバイスの将来技術として大いに貢献するものと考えます。</p> <p>本研究成果の一部は日本応用物理学会欧文誌 vol44, No19 号巻で掲載予定です。</p>
発表日時	平成 17 年 4 月 4 日（月）11:00 報道解禁は平成 17 年 4 月 4 日（月）11:00 ですのでこれを厳守してください。
発表主体	東北大学電気通信研究所、日立製作所基礎研究所
担当課室	研究振興局情報課 担当 金澤宏幸
発表場所	日立本社（東京・丸の内）広報部（23F）
発表形態	日立本社において 11:00 より会見（報道資料およびスライド使用）
備考	<p>照会先 株式会社日立製作所中央研究所企画室 [ 担当：内田、木下 ] 〒185-8601 東京都国分寺市東恋ヶ窪 1-280 TEL(042)327-7777(ダイヤルイン)</p> <p>報道機関お問合せ先 株式会社日立製作所コーポレート・コミュニケーション本部広報部 [ 担当：稲見 ] 〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 TEL(03)5208-9324(ダイヤルイン)</p>